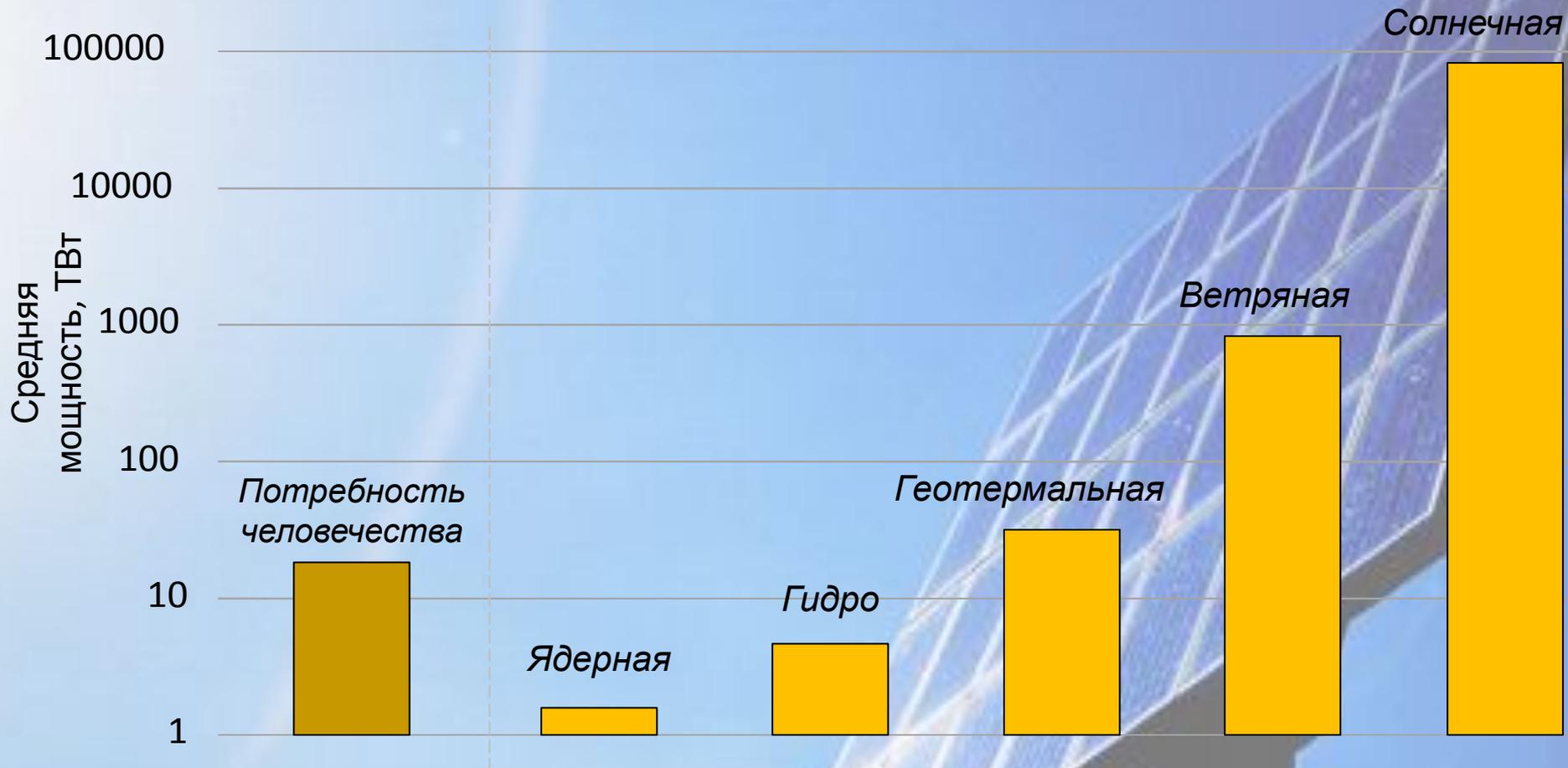


Кремний для солнечной энергетики

И.А. Елисеев

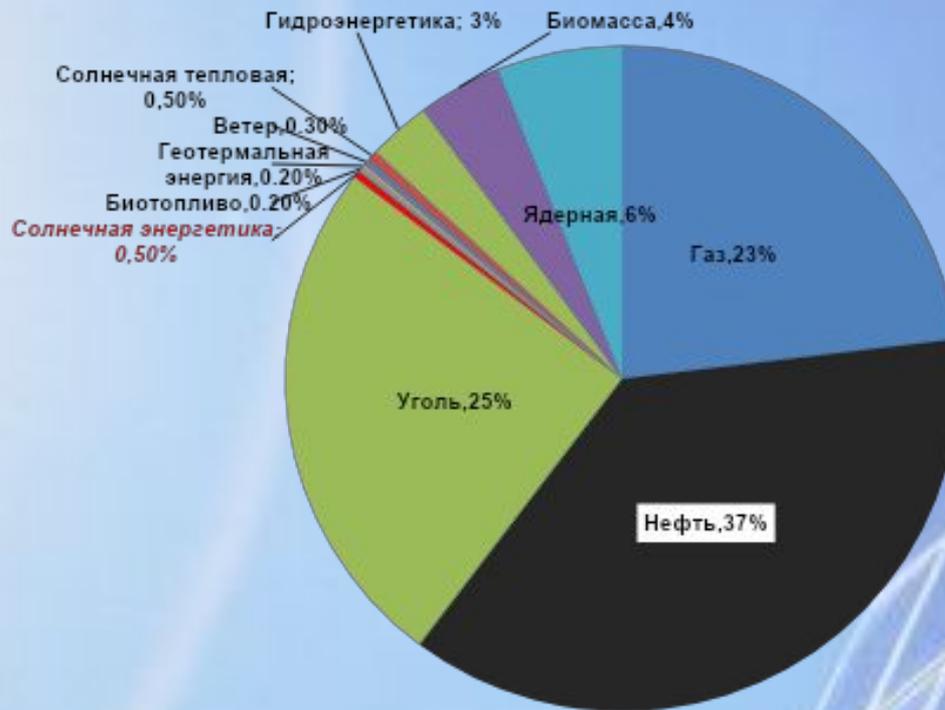
г. Иркутск, Институт геохимии СО
РАН.

Потенциал роста мощностей альтернативных источников энергии



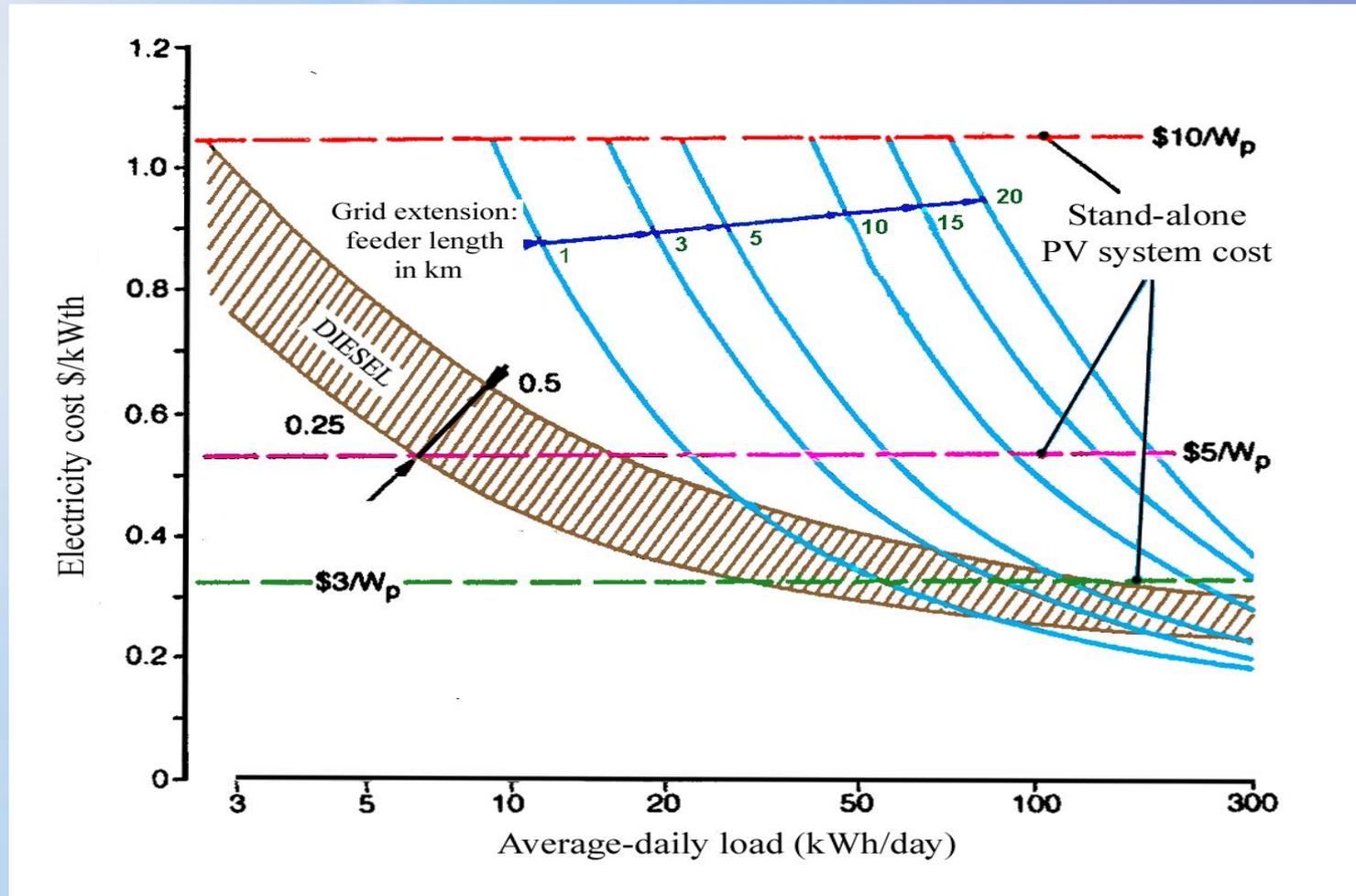
*Источник: W.A. Herman. Energy 31, 13490-1366 (2006)

Глобальное потребление электроэнергии

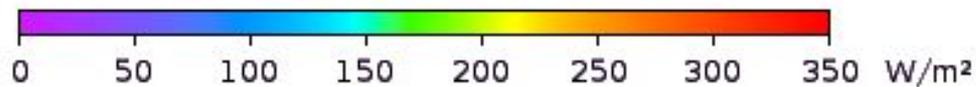
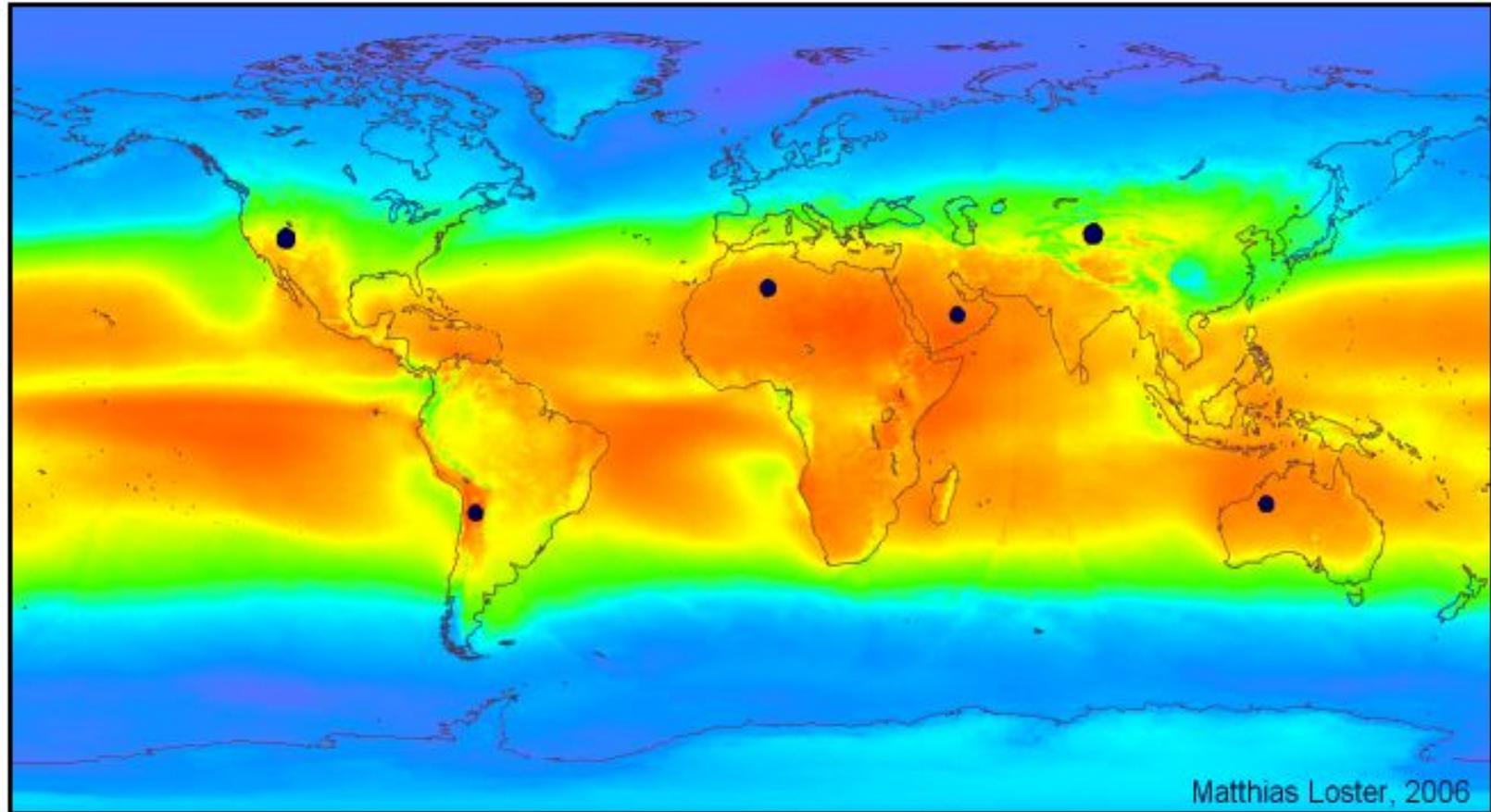


- Мировое потребление энергии: 16 500 ТВтч/год
- Оценка доли выработки энергии от PV: 90 ТВтч/год
- Доля выработки энергии от PV: 0.50%.
- Доля выработки энергии от PV в Европе достигнет более 12% к 2020 году. (По данным EPIA <http://www.epia.org/>)

Стоимость получаемой электроэнергии.



Текущая стоимость модуля – \$2.6(\$3.8) /W (<http://www.aliexpress.com/product-gs/282978347-poly-solar-panel-wholesalers.html>),
2020 – ≤1 \$/W, 2030 – ≤0.5 \$/W



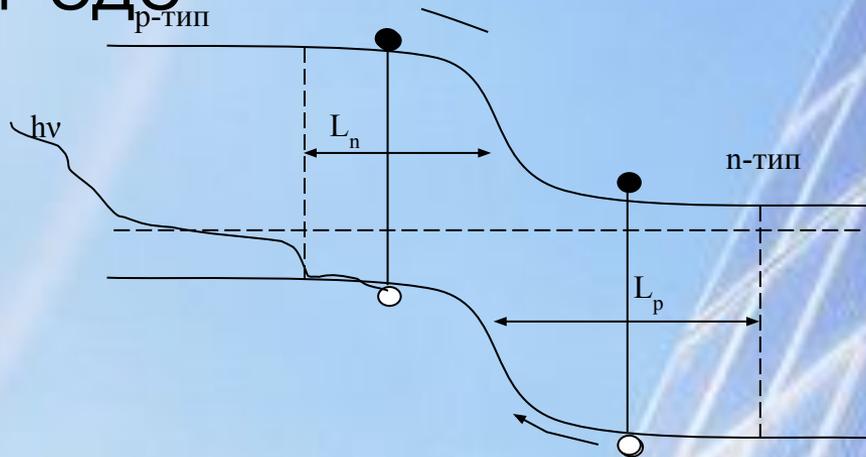
$$\Sigma \bullet = 18 \text{ TWe}$$

На расстоянии в одну астрономическую единицу (то есть на орбите Земли) количество энергии, проходящей через площадку единичной площади, равна приблизительно 1367 Вт/м²

Фотовольтаический эффект

Впервые фотовольтаический эффект наблюдался в электролитической ячейке Эдмондом Беккерелем в 1839 году.

- При освещении полупроводника светом происходит образование электронно-дырочных пар
- В поле р-n перехода происходит разделение зарядов и возникает ЭДС



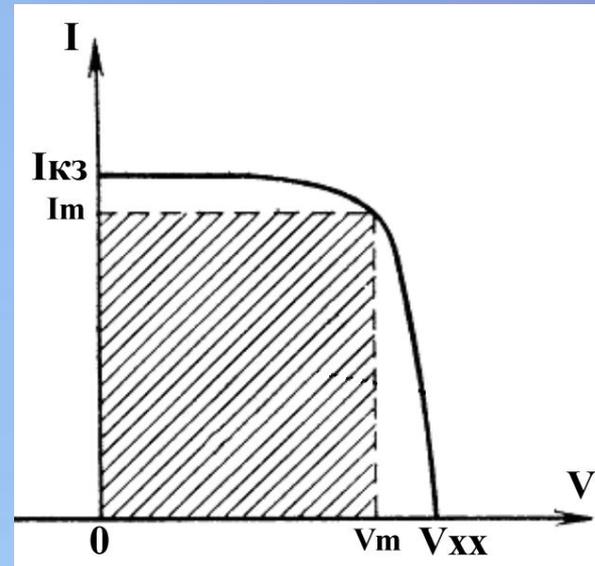
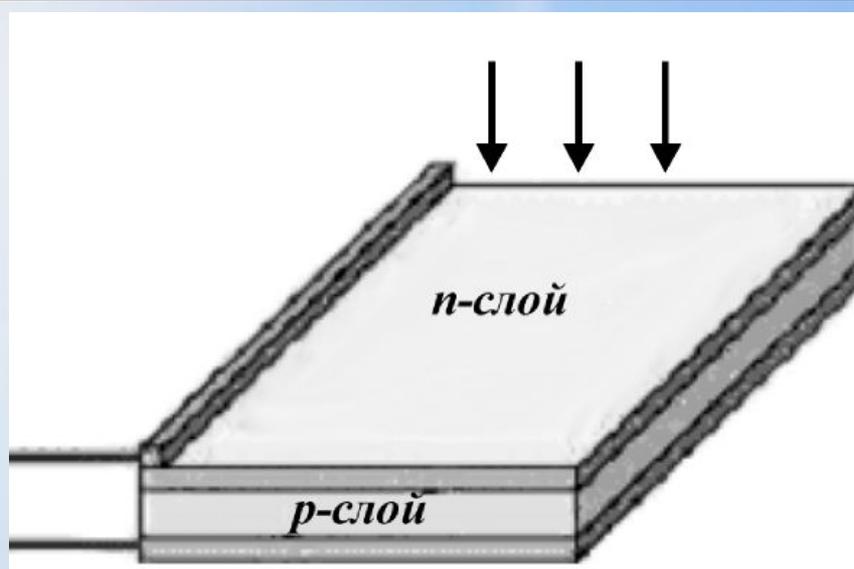
$$U_{pv} = kT/e \ln(1 + (I_f - I) / I_s),$$

Где I - ток во внешней цепи, I_s - ток насыщения р-n перехода, I_f - добавочный ток фотоэффекта

- Первые эксперименты с твердотельными фотоэлектрическими элементами на основе селена проводились в 1876 году в Лондоне под руководством Адамса и Дея.
- В 1939 году в СССР в ФТИ АН СССР под руководством академика А.Ф.Йоффе были разработаны серно-таллиевые фотоэлементы с запорным слоем с эффективностью чуть более 1 %. Тем не менее уже в 1938 году академиком А.Ф.Йоффе была впервые представлена перед Правительством СССР программа использования солнечных фотоэлектрических крыш.
- Решающим в развитии солнечной фотоэнергетики явилось создание в начале пятидесятых годов двадцатого столетия кремниевых фотоэлектрических преобразователей с p-n переходами, имеющими КПД около 6 %.

- **Первое практическое применение солнечных элементов было в космосе. В 1958 году были запущены искусственные спутники Земли оснащенные кремниевыми солнечными батареями: советский «Спутник-3» и американский «Авангард-1».**
- **В начале 1960-х годов были созданы первые солнечные элементы с p-n переходом на основе арсенида галлия. Солнечные батареи на основе арсенида галлия были установлены на космических аппаратах, работающих в окрестностях Венеры (1965 год), а также на самоходных аппаратах «Луноход-1» и «Луноход-2», исследующих поверхность луны (1970 и 1972 годы)**

Основные принципы работы солнечного элемента



Эффективность преобразования (КПД):

$$\eta = FF \times I_{кз} \times V_{хх} \times 100\% / P_{in}$$

где P_{in} – общая мощность падающего солнечного излучения

$I_{кз}$ – ток короткого замыкания (при $V=0$)

$V_{хх}$ – напряжение холостого хода (при $I=0$)

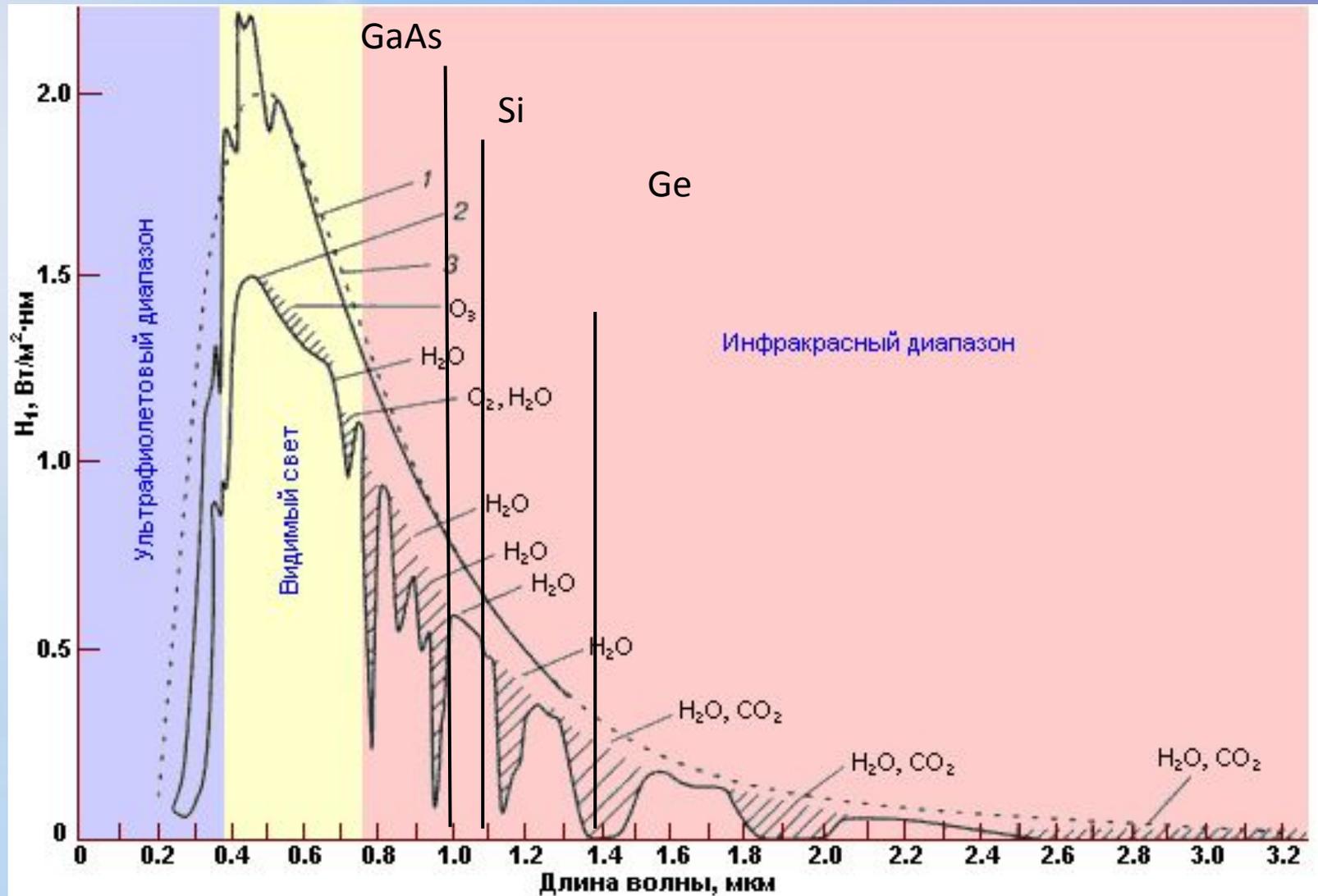
Отношение площади $I_m \times V_m$ к общей площади ВАХ называют фактором заполнения (FF)

$$V_{хх} = A \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{кз}}{I_T} + 1\right)$$

где A – коэффициент “совершенства” барьера,
 I_T – темновой ток

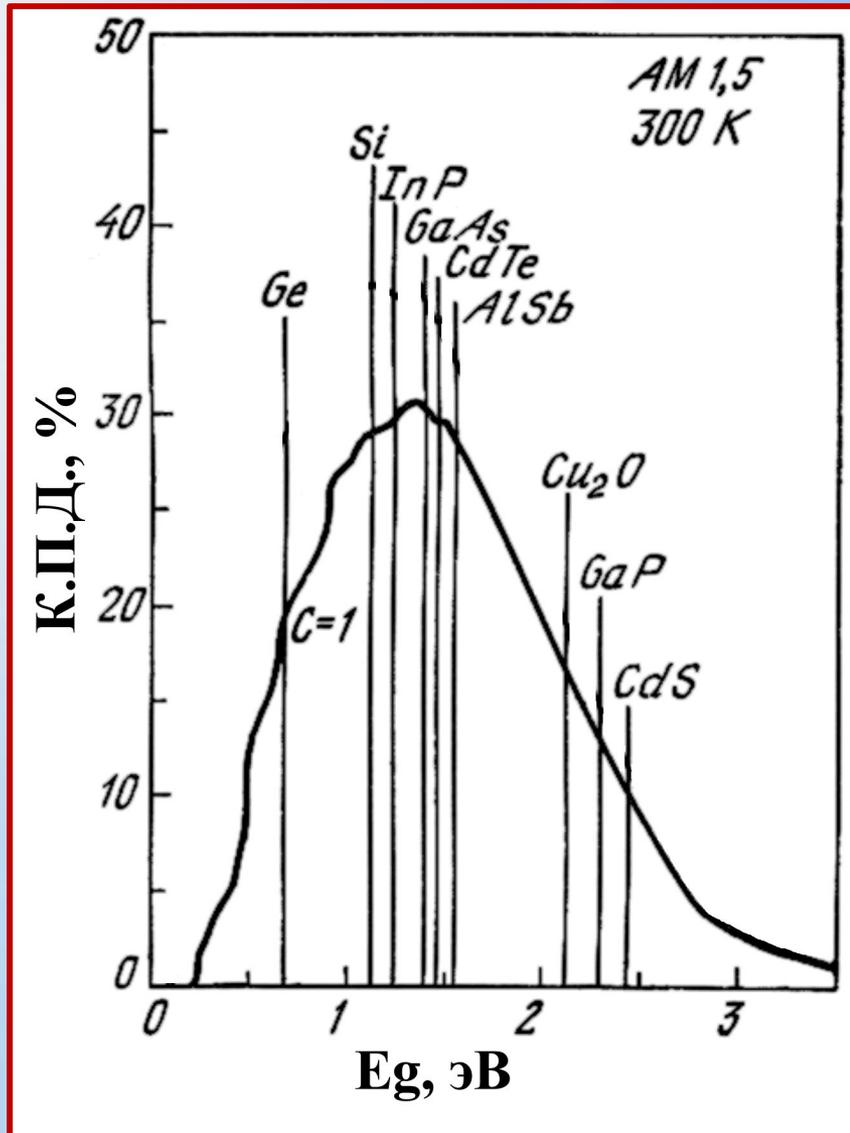
Необходимые условия для эффективной работы СЭ

- ✓ Высокий коэффициент λ для более полного поглощения излучения в толщине слоя;
- ✓ Уменьшение отражения за счет просветляющих покрытий;
- ✓ Генерируемые носители заряда должны эффективно собираться на контактных электродах;
- ✓ Значительная высота барьера в p - n переходе;
- ✓ Низкое сопротивление контактов, чтобы уменьшить потери мощности (джоулево тепло);



Интенсивность падающего на Землю солнечного излучения (H_1) в зависимости от длины волны.

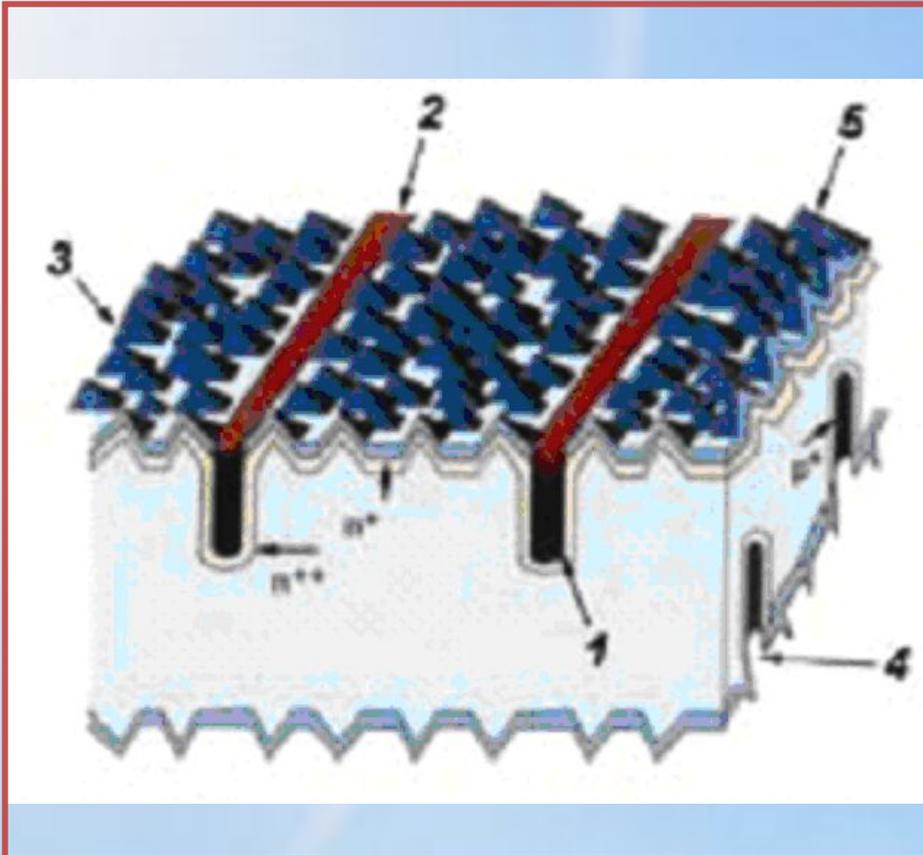
Заштрихованные области соответствуют участкам спектра, ненаблюдаемым на уровне моря из-за их поглощения указанными компонентами атмосферы. 1 — солнечное излучение за границей атмосферы, 2 — солнечное излучение на уровне моря, 3 — излучение абсолютно черного тела при 5900 К. (Справочник по геофизике и космическому пространству. Под ред. С.Л.Валлея и МакГроу-Хилла, Нью-Йорк, 1965)

Зависимость идеального КПД СЭ от E_g 

Все материалы с E_g от 1 до 2 эВ пригодны для создания СЭ

- кристаллический Si ($E_g = 1.1$ эВ)
- аморфный Si (E_g от 1.7 до 1.9 эВ)
- поликристаллический кремний ($E_g \approx 1.45$ эВ)
- Монокристаллический GaAs ($E_g = 1,4$ эВ)

ФЭП на моно-Si с рекордным значением КПД



Высокоэффективный (к.п.д. 24,7%) солнечный элемент Центра фотовольтаики в Сиднее (1995г) :

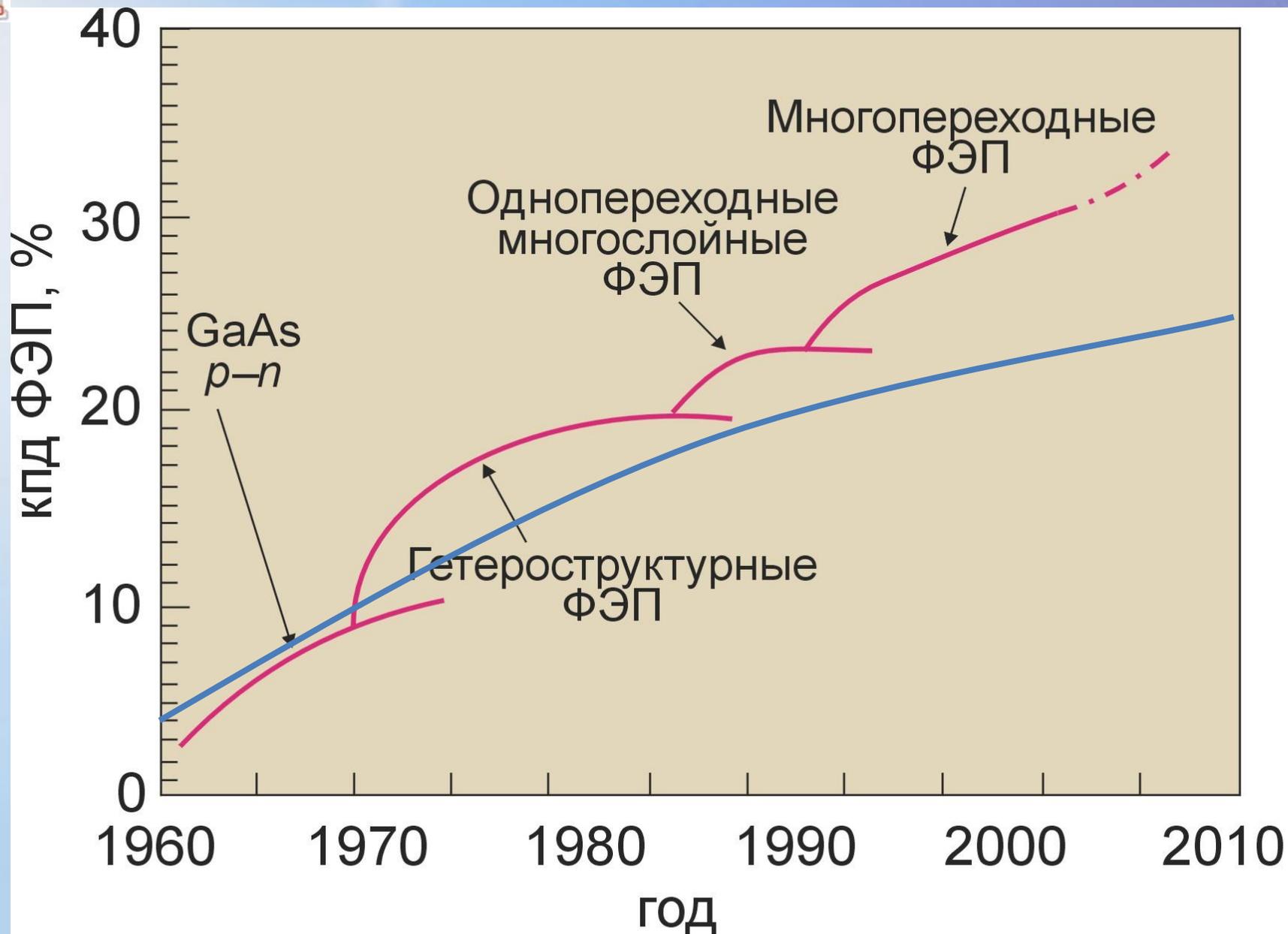
- 1 — паз, прорезанный лазерным лучом и заполненный расплавом металла,
- 2 — верхний контакт,
- 3 — структурированная поверхность,
- 4 — нижний контакт,
- 5 — окисная пленка

В массовом производстве самое высокое к.п.д. (17%) имеют СЭ размером 125×125 мм, выпускаемые в Испании на заводе фирмы BP Solar с 1991 года.

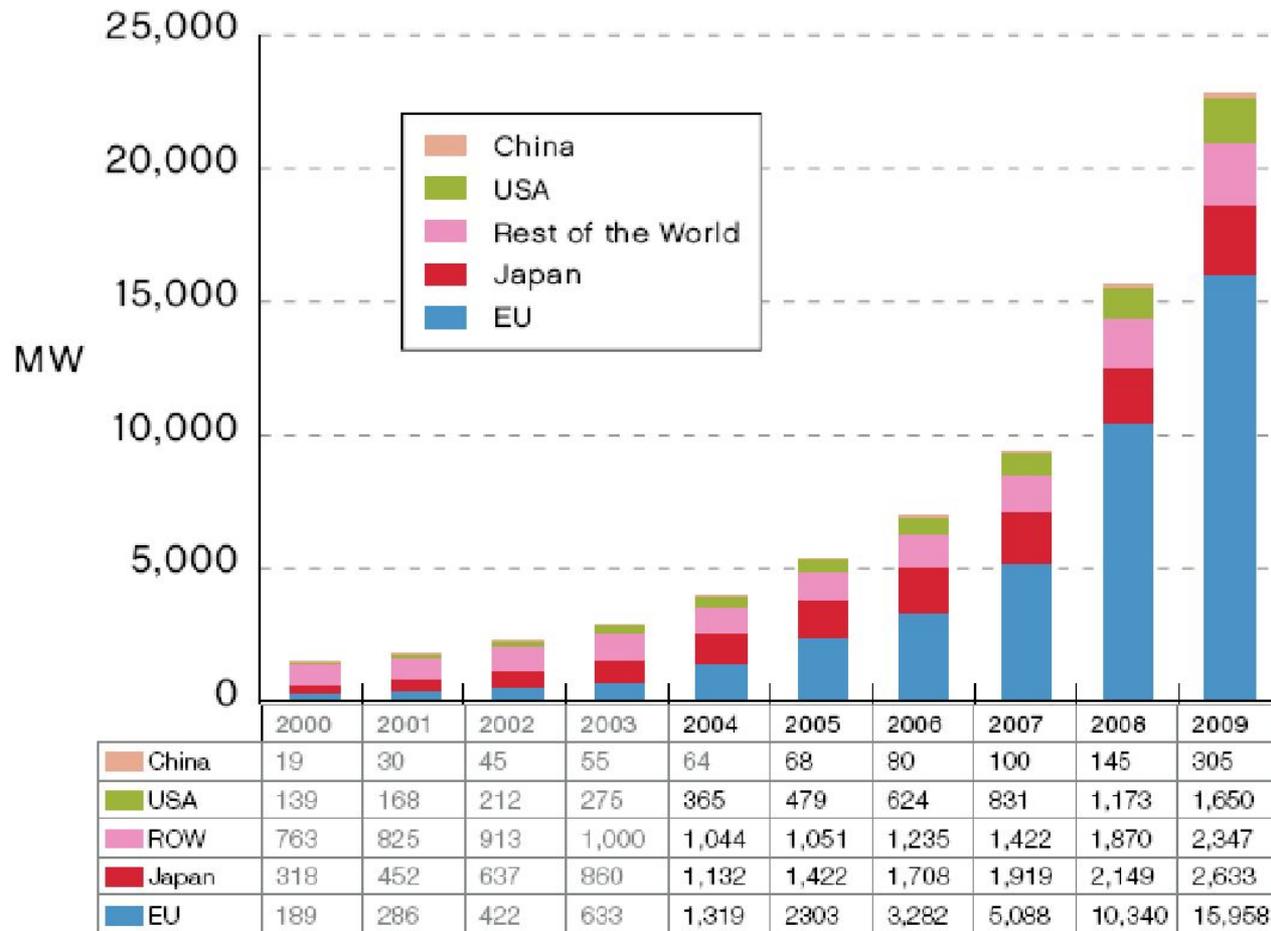


Теоретические, ожидаемые и достигнутые значения КПД каскадных солнечных элементов

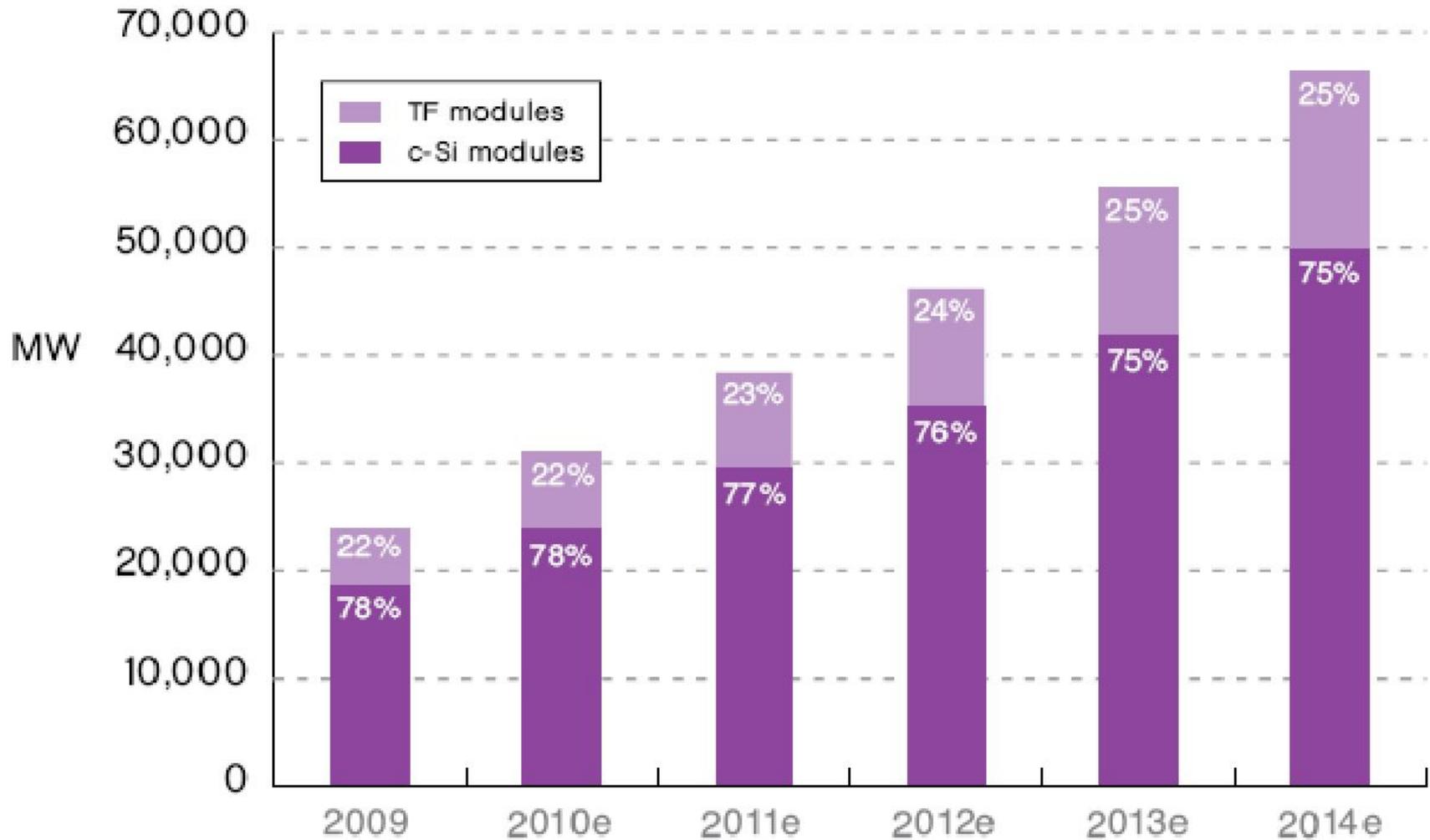
Спектр солнечного излучения	Значение	КПД, %				
		Количество <i>p-n</i> - переходов в каскаде				
		1	2	3	4	5
В условиях околоземного космоса (AM0)	Теоретическое	28	33	38	42	45
	Ожидаемое	23	28	33	36	38
	Реализованное	21.8	27.2	29.3	—	—
В наземных условиях (AM1.5)	Теоретическое	30	36	42	47	49
	Ожидаемое	27	33	38	42	44
	Реализованное	25.1	30.3	31.0	—	—
В наземных условиях с концентрацией (AM1.5)	Теоретическое	35	42	48	52	54
	Ожидаемое	31	38	43	47	49
	Реализованное	27.6	31.1	34.0	—	—



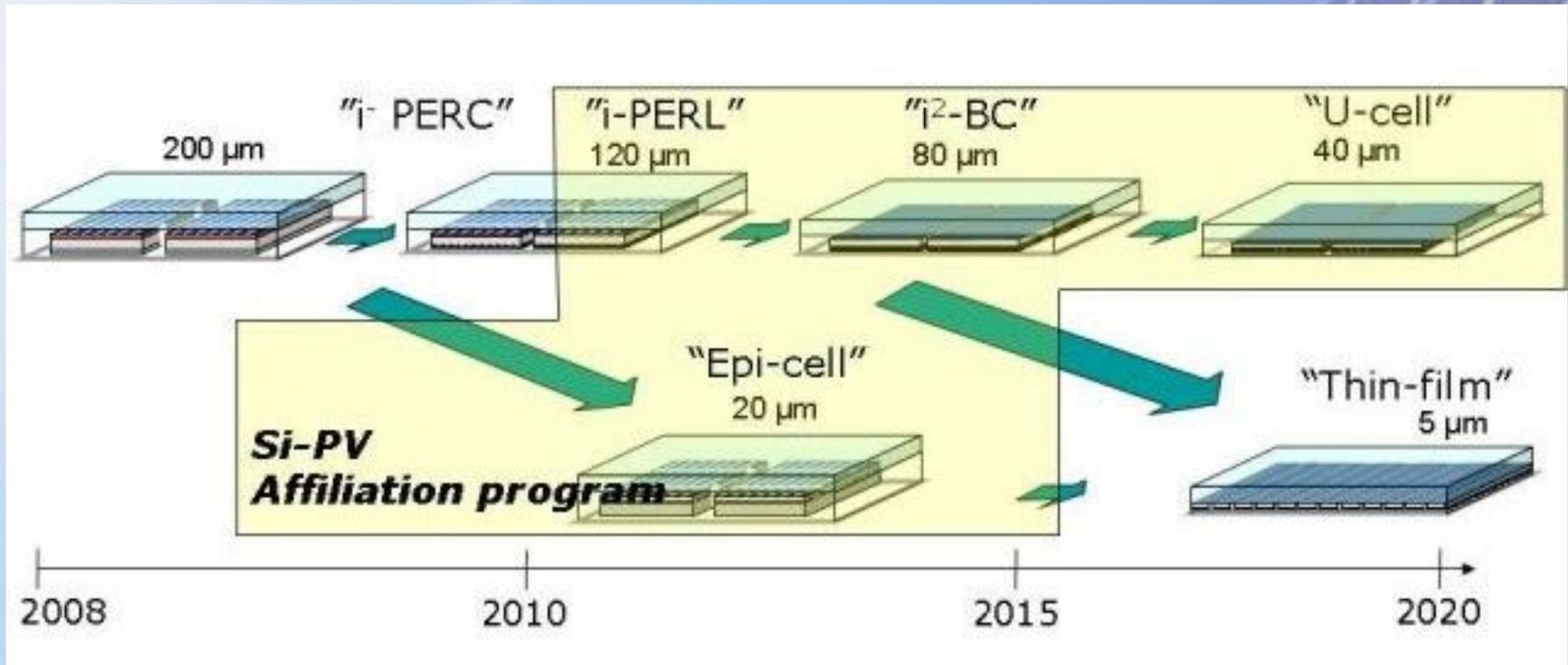
К концу 2009 года общий объем установленных мощностей солнечных энергосистем составил



Мировой объем инсталлированных энергосистем

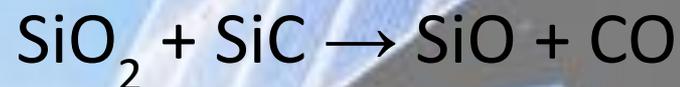
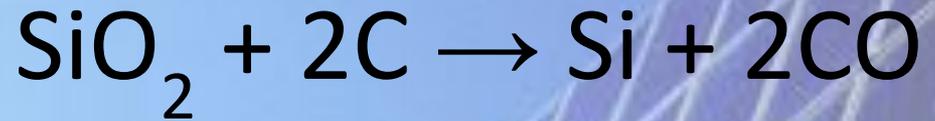


Соотношение солнечных модулей на пластинах кремния и тонкопленочных



<http://www.imec.be/ScientificReport/SR2009/HTML/1213355.html>

Получение технического кремния

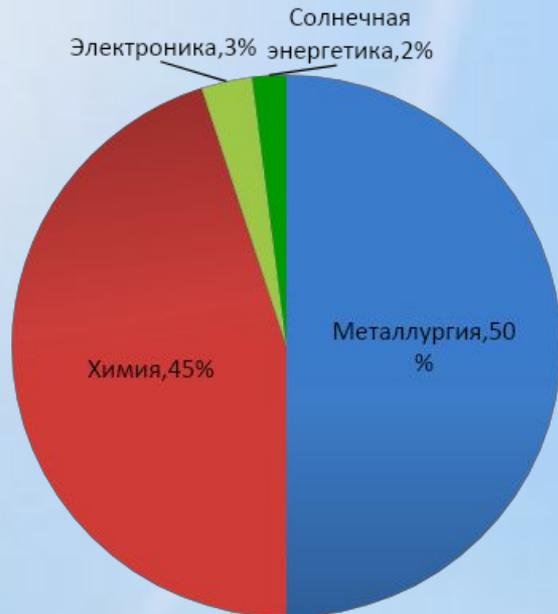




Применение технического кремния

Мировое производство технического кремния – более 1 млн. ТОНН.

Производство технического кремния в России – более 250 тыс. ТОНН.



Стоимость технического кремния

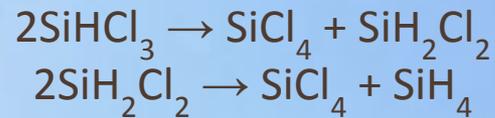


Моносилановый процесс

Кремний технический



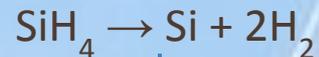
Трихлорсилан



Моносилан - сырец

Ректификация

Высокочистый моносилан

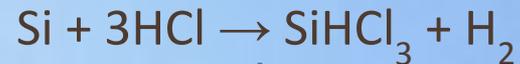


Высокочистый поликремний

SiCl_4 и H_2 возвращаются в процесс

Трихлорсилановый процесс

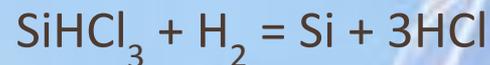
Технический кремний



Трихлорсилан - сырец

Разделение / Ректификация

Высокочистый трихлорсилан



Высокочистый поликристаллический
кремний

Отходящие газы: SiHCl_3 , SiCl_4 , HCl , H_2

Сегодня (на конец 2010 года) мировое производство поликристаллического кремния составляет около 130 тыс. тонн в год. Крупнейшими в мире производителями поликристаллического кремния являются корпорации:

- **Hemlock Semiconductor (capacity 2010: 36 kt) from USA**
- **Wacker Chemie (capacity 2010: 25 kt) from Germany,**
- **GCL-Poly (capacity 2010: 18kt) from Hongkong,**
- **OCI (capacity 2010: 17 kt) from South Korea,**
- **MEMC Electronic Materials (capacity 2010: 8 kt) from USA,**
- **Renewable Energy Corporation ASA (REC) (capacity 2010: 17kt)from Norway**
- **Tokuyama (capacity 2010: 8,2 kt) from Japan.**

**Усолье-Сибирское,
Нитол-Силикон**
поликристаллический
кремний
3 500 тонн/год



Хулун-Буир
Производство поликристаллического
кремния 3 000 тонн/год

Маньчжурия
Производство поликристаллического
кремния 1 000 тонн/год

Холингор
Производство монокристаллического
кремния 1 000 тонн/год

Муданьцзян
Производство поликристаллического
кремния 3 000 тонн/год

Хэйхэ
Производство поликристаллического
кремния 1 500 тонн/год
Производство поликристаллического
кремния 5 000 тонн/год и производство
промышленного кремния 140 000 тонн

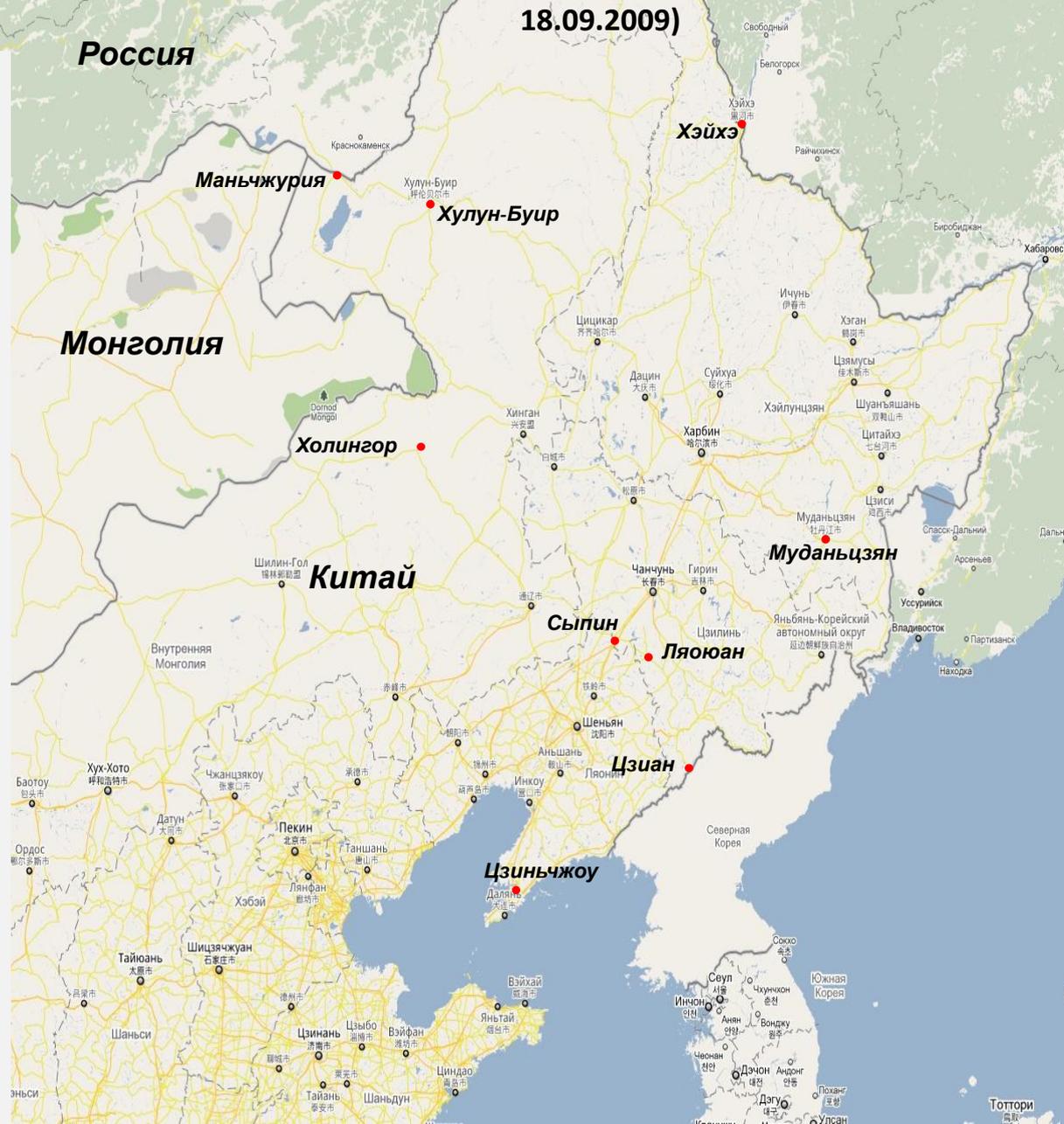
Сыпин
Производство пленочных батарей солнечных
элементов из аморфного кремния 30
МВт/год

Ляоюан
Производство линии солнечных элементов
300 МВт/год

Цзиан
Производство поликристаллического
кремния марки SOG6N 1 000 000 тонн/год

Цзиньчжоу
Создание центра по исследованию
поликремниевых технологий и
производственной линии по выпуску данной
продукции с мощностью 1 500 тонн/год

***из Программы сотрудничества между регионами
Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-
Востока Китая(2009-2018) (утверждена Д.А.Медведевым
18.09.2009)**



2008



2009
 First polysilicon run completed in the 1000 MT facility on January 14, 2009



World Class Solar Company **2GW/year**



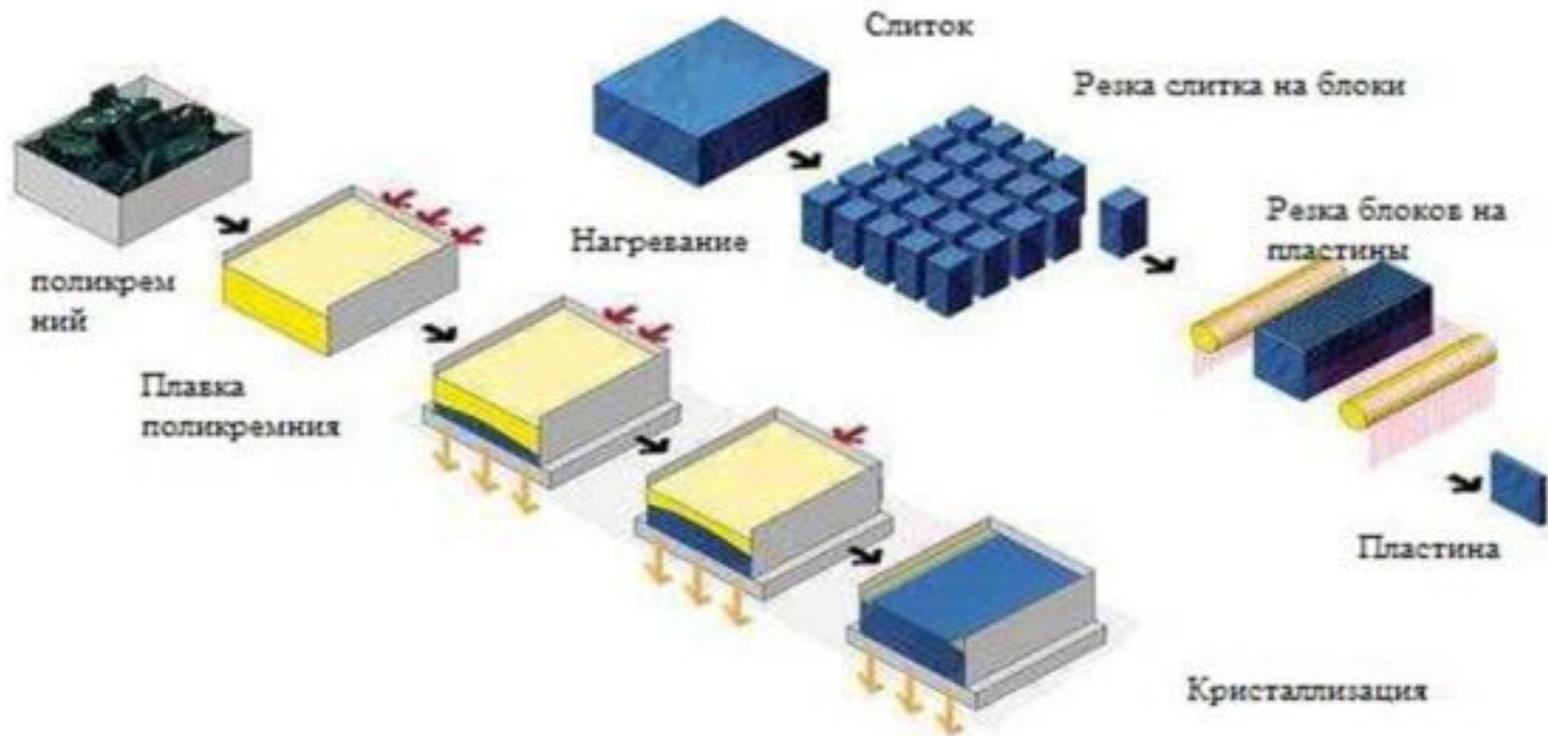
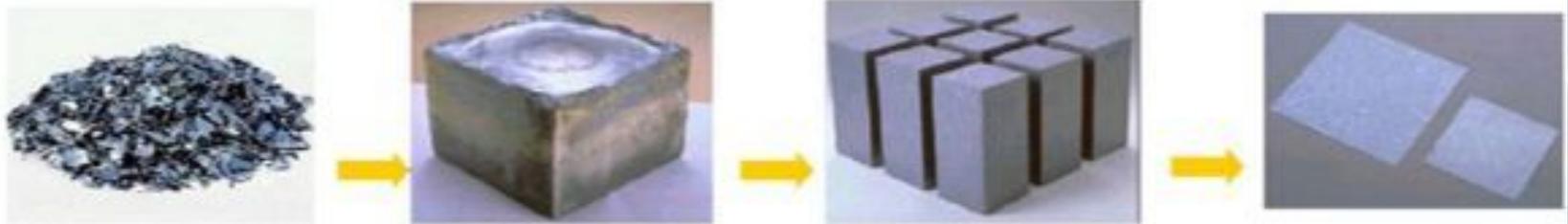
□TХC – 10 000 т/г

□polySi – 3 500 т/г





Этапы получения пластин для солнечной энергетики

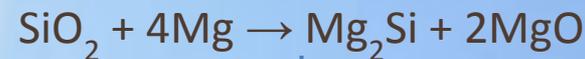


Соотношение цена – качество на различных этапах производства кремния

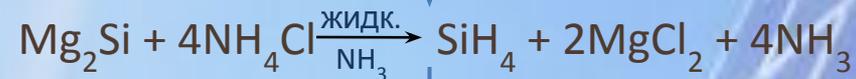


Силицидный процесс

Смесь порошков SiO_2 и Mg



Силицид магния



Моносилан - сырец

Ректификация моносилана

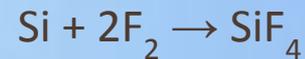
Высокочистый моносилан



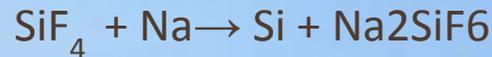
Высокочистый поликремний

Фторидно-гидридный процесс

Кремний технический



Тetraфторид



Кремнефториднатрия

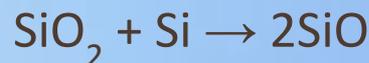
Термолиз $\text{NaF} \rightarrow$

Кремний (порошок)
чистота 99,99%

Возможно
использование
Ca, Mg ..

Моноксидный процесс

Смесь порошков
-кремний (чистота 98%)
--диоксид кремния (чистота 99,9%)



Моноксид кремния
чистота 99,99%



Кремний (порошок)
чистота 99,99%

Финишная очистка и переплав в гранулы

Гранулированный кремний
чистотой 99,999%

Прямое рудотермическое восстановление

Кварцевое сырье
чистота > 99,99%

Углеродная сажа
чистота > 99,99%

Восстановление в
электродуговой печи

Технический кремний
чистота > 99,99%

Финишное
рафинирование
Направленная кристаллизация

Солнечный кремний
чистота > 99,999%

Требуется специальная
подготовка сырьевых
материалов

Вместо углерода можно
использовать металлы:
Al, Mg, Zn

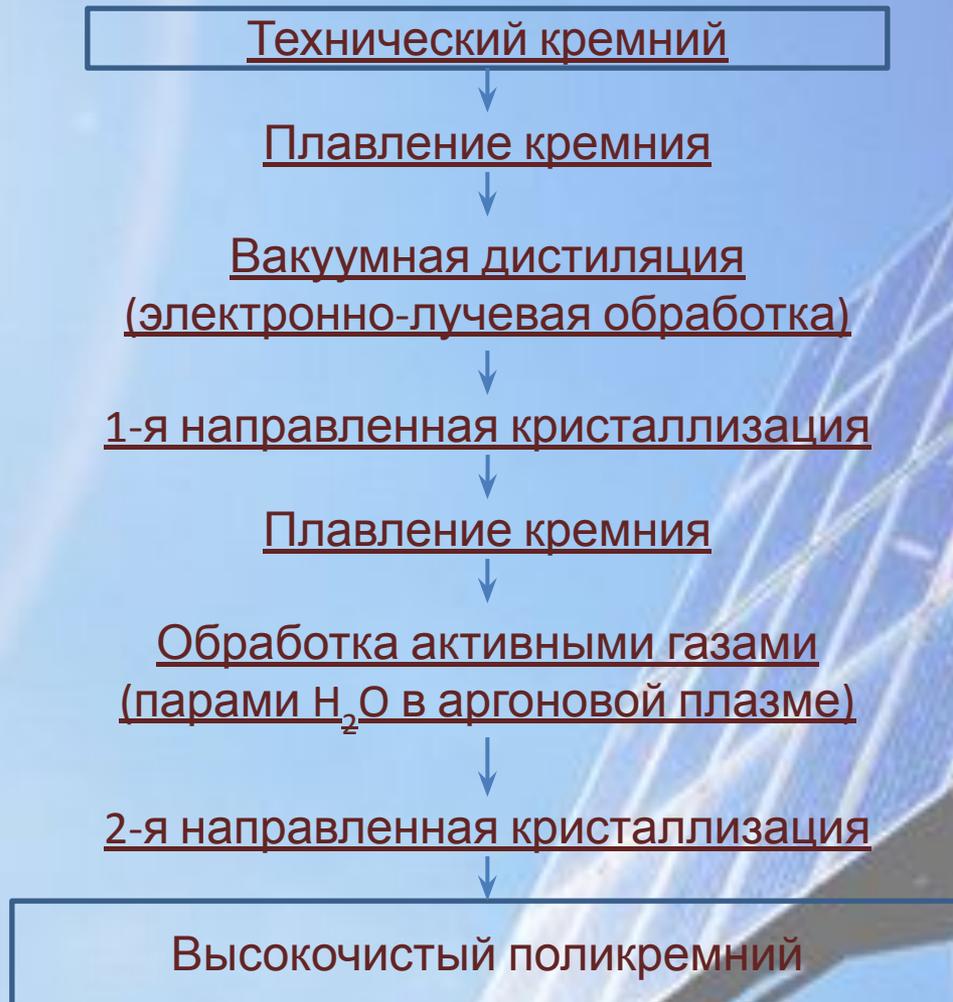
Процесс реализуется в
пилотном производстве ПКК
высокой чистоты фирмой
«Solsilc Development Co»
(Нидерланды)

Разработчики процесса в
России

ИНХ СО РАН (Новосибирск)
ИГХ СО РАН (Иркутск)

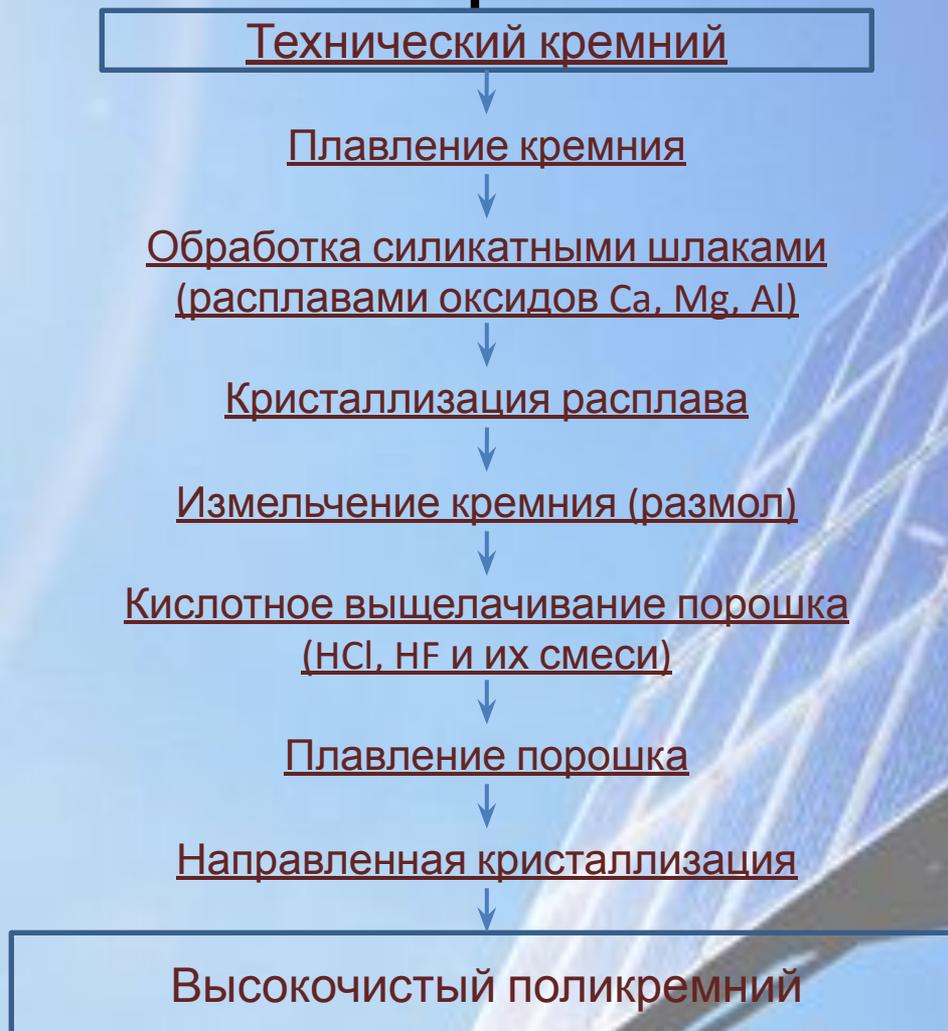
Рафинирование технического кремния

Технология JFE Steel (Япония)



Рафинирование технического кремния

Технология Elkem ASA (Норвегия)



Начало работ по тематике «Солнечный кремний» в Институте геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН – 1996 год

30 марта 1998 года
Институтом геохимии
им. А.П.Виноградова СО
РАН
получен патент
Способ получения
кремния высокой
чистоты



Февраль 1999: получение высокочистого кремния на одной из 25 MVA печей ЗАО «Кремний»



Экспериме

нт



В 2003 был проведен эксперимент на 16,5 МВт электротермической печи на ЗАО “Кремний” (г.Шелехов). Масса расплава кремния в ковше была 3000 kg, количество водяного пара 9 kg и количество воздуха 206 m^3 . Для эксперимента был специально разработан и изготовлен генератор влажности.

Генератор газовой смеси

ГГС –Изготовленный в Институте геохимии аппарат предназначенный для отработки режимов рафинирования расплава металлургического кремния в ковше промышленных рудно-термических печей (РТП) с массой расплава кремния от 800 до 3 000 кг. Предназначен для отчистки кремния от бора, фосфора и легких металлов . При этом за счет конструктивных особенностей ГГС возможно гибко изменять параметры проведения рафинирования.



Эксперимент Декабрь 2006: получение высокочистого кремния на одной из 20 MVA печей ТОО МК «Kaz Silicon»



*Разработана принципиально новая технология
получения мультикремния для солнечной
энергетики.*



Схема технологии прямого получения SoG мультикремния из высокочистого рафинированного MG кремния.

Лабораторная линия для получения мультикремния



Рис. . Лабораторная линия полного цикла получения мультикремния для изготовления солнечных элементов:
А – Дуговая печь для восстановления двуокиси кремния до кремния. Аналог металлургической печи для получения кремния.
Б – Высокотемпературная печь. Предназначена для изучения процессов барботирования кремниевого расплава. Аналогов не имеет.
В – Печь для выращивания слитков мультикремния.
Г – Тигель для рафинирования кремния
Д – Слиток мультикремния

A scenic view of a rocky coastline. A large, dark grey and brown rock face dominates the right side of the frame, extending from the top to the water's edge. The water in the foreground is a vibrant green color, reflecting the light. In the background, a forested hillside is visible under a clear blue sky. The text "Спасибо за внимание!" is overlaid in the center of the image in a white, serif font.

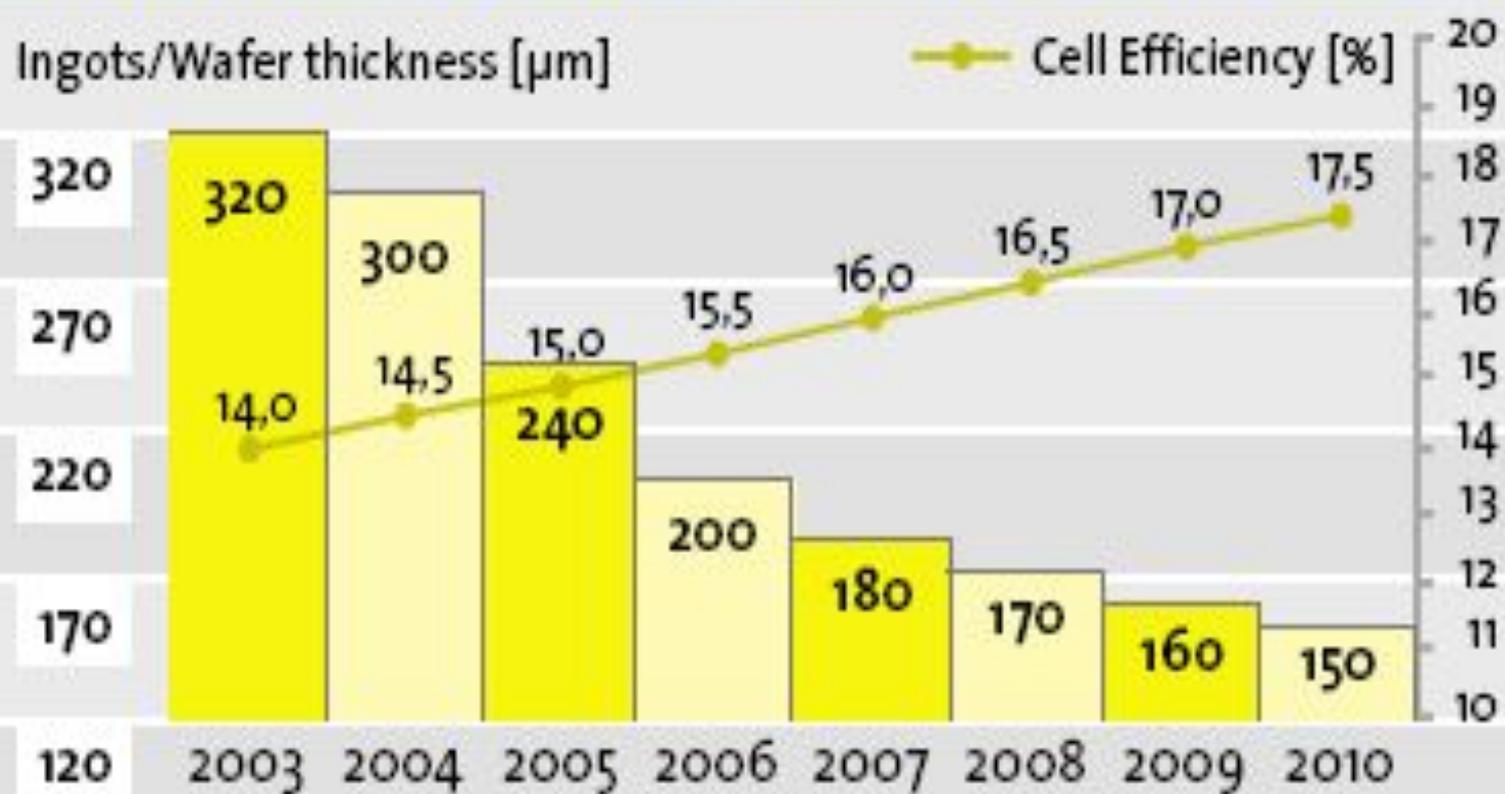
Спасибо за внимание!

Мотивация работы

За последние 10 лет рост мирового производства солнечных элементов составил более 30 % ежегодно. В 2005 произведено 1318 МВт, и достигнет, по прогнозам, 4 ГВт в 2010 году. [Solar Generation III. EPIA, September 2006. <http://www.epia.org/>].



Figure 2.1: Ingots / Wafer Thickness and Cell Efficiency in g/Wp depending on potential module production [MWp]



Source: EPIA, 2005

Электрофизические характеристики кремния используемого для производства солнечных элементов

Параметры	Значения	
Тип проводимости	P	
Удельное сопротивление	Ом*см	0,5-3
Время жизни ННЗ	мкс	>5
Диффузионная длина свободного пробега ННЗ	мкм	>80
Размеры монокристаллов	мм	>2

Регламентируемые примеси при изготовлении солнечных элементов

Углерод – менее 3 ppm

Кислород – менее 10 ppm

Бор – менее 0,3 ppm

Легирующие примеси (P, As) < 0,1
ppm

Металлы $\Sigma < 0.1$ ppm

Требования к SoG кремнию

Содержание примесей в SoG кремнию (не более,

<i>ppm)</i> <i>Carbon</i>	<i>3</i>	<i>Copper</i>	<i>0.1</i>
<i>Oxygen</i>	<i>10</i>	<i>Nickel</i>	<i>0.1</i>
<i>Boron</i>	<i>0.3</i>	<i>Chromium</i>	<i>0.01</i>
<i>Phosphorous</i>	<i>0.2</i>	<i>Manganese</i>	<i>0.01</i>
<i>Sodium</i>	<i>0.2</i>	<i>Iron</i>	<i>0.03</i>
<i>Magnesium</i>	<i>0.2</i>	<i>Cobalt</i>	<i>0.01</i>
<i>Potassium</i>	<i>0.5</i>	<i>Zinc</i>	<i>0.1</i>
<i>Aluminium</i>	<i>0.1</i>	<i>Barium</i>	<i>0.1</i>
<i>Titanium</i>	<i>0.001</i>	<i>Calcium</i>	<i>0.1</i>